

SKY LANE スカイレーン Plating Using the Full Auto Equipment 自動めっき装置

銅めっき、Niめっき、Auめっきの複合めっきが可能な最新の半導体装置です。

銅とニッケルのアノードのプロセスコストが大幅に削減され、金のプロセスコストも大幅に削減できます。

当社独自のオールラウンドコンタクト
ウエハへの優れた電流分布、
高速めっきが可能であり、めっきの均一性にも優れています。

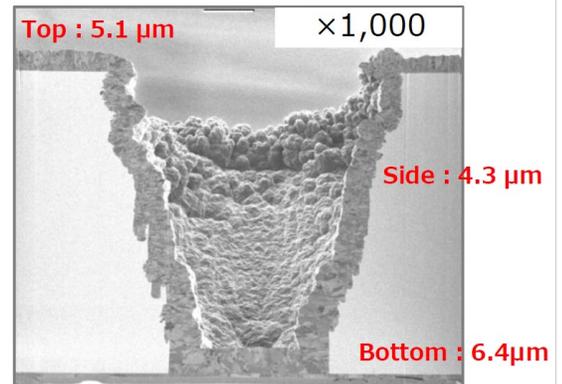
Applications

- ・ウエハハレベルのパッケージング
- ・フリップチップ相互接続
- ・はんだバンピング（ニッケル&はんだメッキ付）
- ・C4バンプ
- ・ボンディングなど



ウエハ処理の Solstice プラットフォームは、必要なアプリケーションに応じて、カスタマイズ可能な構成で 8 チャンバー、4 チャンバー、3 チャンバー、または 2 チャンバーで利用できます。

Thickness uniformity in a wafer via



High-uniformity gold plating from the SKY LANE

Features

- ・フェイスダウンめっきチャンバー
- ・全周コンタクトリング
- ・自動液補給ソリューションシステム
- ・ダブル（ドライ&ウェット）ハンドスカロボット
- ・8インチ×8チャンバーシステム
- ・2 スピンリンスドライヤー

Technical Spec	
ウエハ サイズ	150-200mm
ウエハ タイプ	Notch / Flat
ウエハ 厚み	200 μ m to >6mm
ウエハ 材質	Silicon GaAs GaN on Si, GaN on Sapphire Sapphire Transparent substrates and more
チャンバー数	8 chamber
装置サイズ8C	W2300 × L4200 × H2200 (mm)
制御盤サイズ	W800 × L800 × H2000 (mm)
電源	220V 3P 125A
めっきタンク容量	70ℓ
温度制御	±2°C
整流器電源容量	20A
流量コントロール	25 lpm
めっき速度	>3 μ m/minute, up to 6.5 μ m/minute(※about)
ウエハ膜厚均一性	<5% (range 2*mean)
ウエハ間膜厚均一性	<5% (mean-to-mean)
対応電流値	0.2Å on 20Å seed deplate
平面性	<5%
通信仕様	Ethernet and CC Link

UI SCIENCE CO., LTD

1059-5 TAKATA KASHIWA CTIY CHIBA JAPAN 〒277-0861
TEL 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384
e-mail s_umemoto@ui-science.co.jp
<http://www.ui-science.co.jp/>